

トランジスタ

2SD1263, 2SD1263A

2SD1263, 2SD1263A

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形/Si NPN Triple Diffused Planar

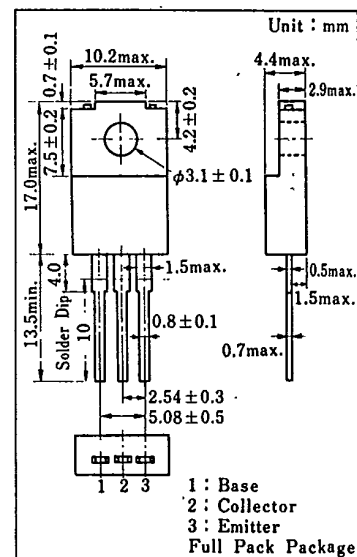
低周波電力増幅用/AF Power Amplifier

■ 特徴/Features

- コレクタ・ベース電圧 V_{CBO} が高い。/High V_{CBO}
- 放熱板への取り付けがビス1本で可能な“フルパック”パッケージ。/“Full Pack” package for simplified mounting only by a screw, requires no insulator.

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	350	V
		400	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	250	V
		300	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	1.5	A
コレクタ電流	I_C	0.75	A
コレクタ損失	P_C	35	W
		2	
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・シャ断電流	I_{CES}	$V_{CE} = 350\text{ V}, V_{BE} = 0$			1	mA
		$V_{CE} = 400\text{ V}, V_{BE} = 0$			1	
コレクタ・シャ断電流	I_{CEO}	$V_{CE} = 150\text{ V}, I_B = 0$			1	mA
		$V_{CE} = 200\text{ V}, I_B = 0$			1	
エミッタ・シャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5\text{ V}, I_C = 0$			1	mA
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = 30\text{ mA}, I_B = 0$	250			V
			300			
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 0.3\text{ A}$	40		250	
	h_{FE2}	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 1\text{ A}$	10			
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 1\text{ A}$			1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 1\text{ A}, I_B = 0.2\text{ A}$			1	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = 1\text{ A}, I_{B1} = -I_{B2} = 0.1\text{ A}$		0.5		μs
蓄積時間	t_{stg}			2		μs
下降時間	t_f			0.5		μs

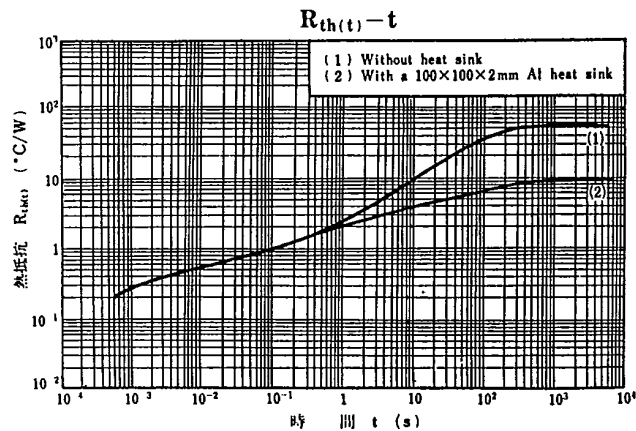
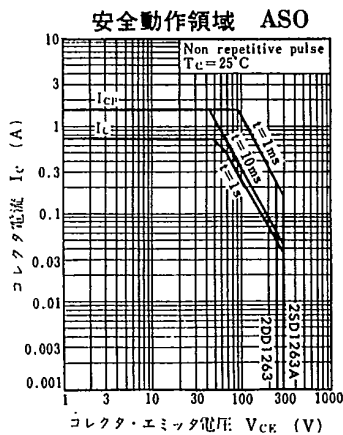
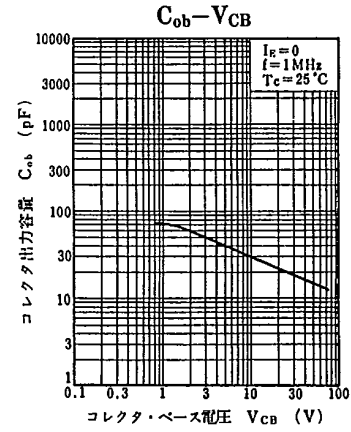
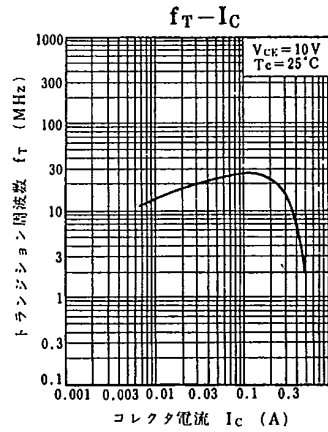
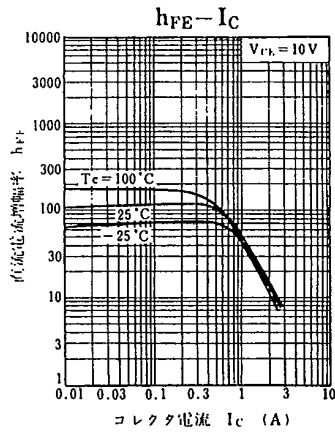
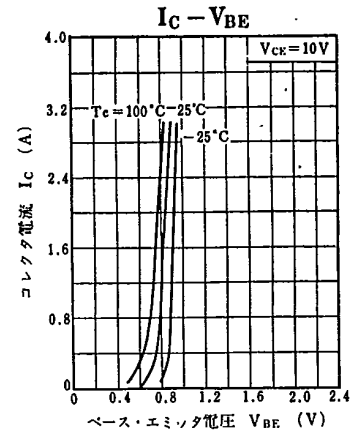
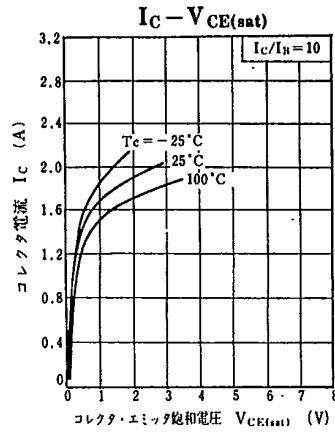
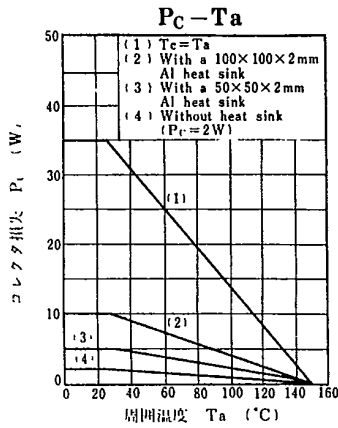
* h_{FE1} ランク分類/ h_{FE1} Classifications

Class	R	Q	P
h_{FE1}	40~90	70~150	120~250

トランジスタ

2SD1263, 2SD1263A

T. 33-11



トランジスタ

2SD1264, 2SD1264A

2SD1264, 2SD1264A

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形/Si NPN Triple Diffused Planar

低周波電力増幅用/AF Power Amplifier

テレビ垂直偏向出力用/TV Vertical Deflection Output

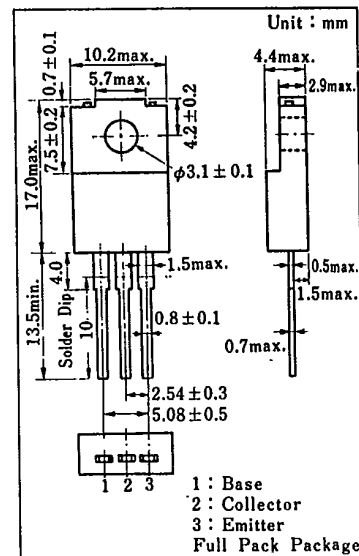
2SB940, 2SB940A とコンプリメンタリ/Complementary Pair
with 2SB940, 2SB940A

■ 特徴/Features

- コレクタ・エミッタ電圧 V_{CE0} が高い。/High V_{CE0}
- コレクタ損失 P_C が大きい。/Large P_C
- 放熱板への取り付けがビス1本で可能な“フルパック”パッケージ。/
“Full Pack” package for simplified mounting only by a screw, requires
no insulator.

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	200	V
コレクタ・ エミッタ電圧	V_{CEO}	150 180	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	3	A
コレクタ電流	I_C	2	A
コレクタ損失	P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	W
		$T_a = 25^\circ\text{C}$	
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 200\text{ V}, I_E = 0$			50	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 4\text{ V}, I_C = 0$			50	μA
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = 500\text{ }\mu\text{A}, I_E = 0$	200			V
コレクタ・ エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = 5\text{ mA}, I_B = 0$	150			V
		$I_C = 5\text{ mA}, I_B = 0$	180			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = 500\text{ }\mu\text{A}, I_C = 0$	6			V
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 150\text{ mA}$	60		240	
	h_{FE2}	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 400\text{ mA}$	50			
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 400\text{ mA}$			1	V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 500\text{ mA}, I_B = 50\text{ mA}$			1	V

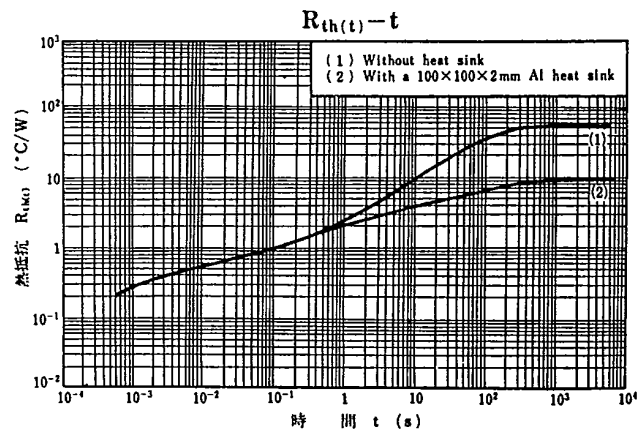
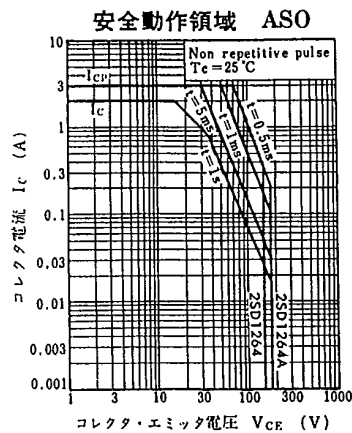
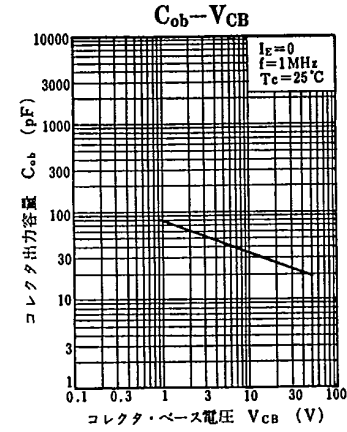
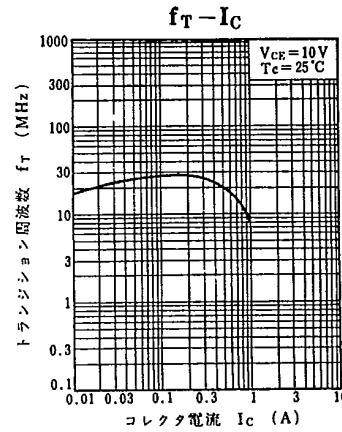
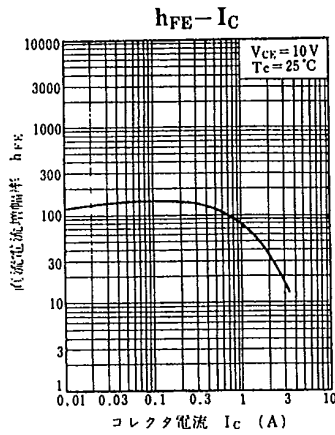
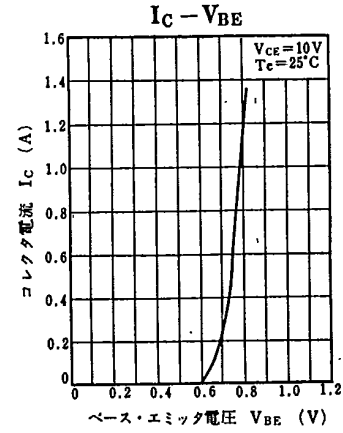
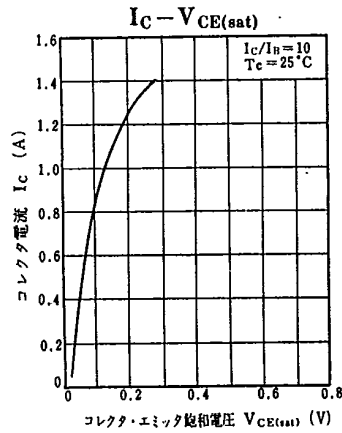
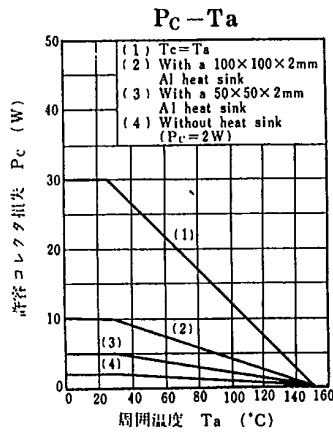
* h_{FE1} ランク分類/ h_{FE1} Classifications

Class	Q	P
h_{FE1}	60~140	100~240

トランジスタ

2SD1264, 2SD1264A

T-33-09



トランジスタ

2SD1265, 2SD1265A

2SD1265, 2SD1265A

T-33-09

シリコン NPN 三重拡散接合形/Si NPN Triple Diffused Junction

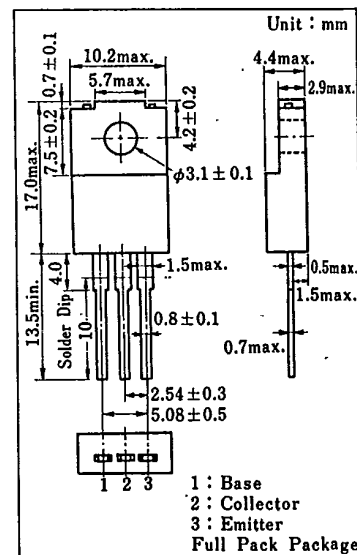
低周波電力増幅用/AF Power Amplifier

■ 特徴/Features

- 安全動作領域 (ASO) が広い。/Wide area of safe operation (ASO)
- 放熱板への取り付けがビス 1 本で可能な "フルパック" パッケージ。/
"Full Pack" package for simplified mounting only by a screw, requires
no insulator.

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	60	V
		80	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	60	V
		80	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	8	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	6	A
コレクタ電流	I_C	4	A
ベース電流	I_B	1	A
コレクタ損失	P_C	30	W
		2	
接合部温度	T_J	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

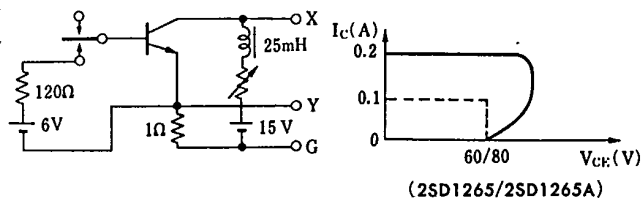
■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CEO}	$V_{CB}=20\text{ V}, I_E=0$			30	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=8\text{ V}, I_C=0$			1	mA
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE(sus)}^{*2}$	$I_C=0.2\text{ A}, L=25\text{ mH}$	60			V
			80			
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=3\text{ V}, I_C=0.1\text{ A}$	40			
	h_{FE2}^{*1}	$V_{CE}=3\text{ V}, I_C=1\text{ A}$	30		160	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=3\text{ V}, I_C=1\text{ A}$			1.2	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2\text{ A}, I_B=0.4\text{ A}$			1	V
シャ断周波数	f_{ae}	$V_{CE}=10\text{ V}, I_C=0.2\text{ A}$		25		kHz

*² $V_{CLO(sus)}$ 測定回路/ $V_{CE(sus)}$ Test Circuit*¹ h_{FE2} ランク分類/ h_{FE2} Classifications

Class	Q	P	O
h_{FE2}	30~60	50~100	80~160

水銀リレー 50/60 Hz



トランジスタ

2SD1265, 2SD1265A

T-33-09

